Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0410U006529

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-12-2010

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Копанець Ігор Євгенович
2. Kopanets Igor Evgenovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.13

Назва наукової спеціальності: Фізика металів

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 14-12-2010

Спеціальність за освітою: 7.090102

Місце роботи здобувача: Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14312223

Місцезнаходження: 61108, м. Харків, вул. Академічна, 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д64.845.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14312223

Місцезнаходження: 61108, м. Харків, вул. Академічна, 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.21

Тема дисертації:

1. Просторовий розподіл та місце локалізації в гратці радіаційних дефектів та домішок інертних газів
2. Depth distribution and lattice site location of radioactive defects and inert gas impurities

Реферат:

1. Дисертація присвячена встановленню закономірностей дефектоутворення, просторово-концентраційних розподілів і місця локалізації в елементарній комірці кристала радіаційних дефектів та імплантованої домішки. З використанням комплексу експериментальних методик показано, що рівні пошкоджуваності, що створюються при опромінюванні різними іонами, корелюють із значеннями енергії, що виділяється в пружних зіткненнях. Встановлений збіг експериментально виміряних профілів дефектів зміщених атомів нікелю та їх комплексів з розрахунковими профілями енерговиділення. Показано, що просторовий розподіл протяжних дефектів корелює з областю глибин між максимумами дефектів і пробігів. Досліджені розподіл, захоплення і утримання дейтерію в сталі Х18Н10Т при підвищених температурах опромінення.

2. The dissertation is devoted to radiation damage formation law establishment, concentration and depth distribution and lattice site location in nickel single crystal elementary cell of radiation defects and admixture. Using the complex of experimental methods it was shown that damage levels corresponding to various ion

implantation cases are in good agreement with separated in elastic collision energy levels. The coincidence of the experimentally measured defect profiles from the displaced nickel atoms and their complexes with the calculated ones was detected. The spatial distribu-tion of extensive defect correlation with the area of depths between defects and range maximums was shown. Deuterium accumulation, trapping and reemission from the Cr18Ni10T stainless steel under the high temperature irradiation were investigated.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Толстолуцька Галіна Дмитрівна
2. Tolstolutskaya Galina Dmitrievna

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пугачов Анатолій Тарасович

2. Пугачов Анатолій Тарасович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сіренко Анатолій Федотович

2. Сіренко Анатолій Федотович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Єгоров Олексій Михайлович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Єгоров Олексій Михайлович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

Юрченко Т.А.